

Содержание

Неведомский В.Н., Берт Н.А., Чалдышев В.В., Преображенский В.В., Путятю М.А., Семягин Б.Р.

Структуры GaAs с квантовыми точками InAs и As, полученные в едином процессе молекулярно-лучевой эпитаксии 1662

Именной указатель 1667

Предметный указатель 1702

● **Обзоры**

Дубровский В.Г., Цырлин Г.Э., Устинов В.М.

Полупроводниковые нитевидные нанокристаллы: синтез, свойства, применения 1585

● **Электронные и оптические свойства полупроводников**

Немов С.А., Тарантасов Г.Л., Прошин В.И., Житинская М.К., Иванова Л.Д., Гранаткина Ю.В.

Тензор Нернста–Эттингсгаузена в монокристалле Sb_2Te_3 1629

● **Полупроводниковые структуры, границы раздела и поверхность**

Пожела Ю., Пожела К., Юцене В., Сужеделис А., Школьник А.С., Михрин С.С., Михрин В.С.

Взаимодействие электронов с локализованными в квантовой яме оптическими фононами 1634

● **Физика полупроводниковых приборов**

Савельев А.В., Новиков И.И., Максимов М.В., Шерняков Ю.М., Жуков А.Е.

Температурная и токовая зависимости ширины спектра генерации в лазерах на квантовых точках 1641

Лютецкий А.В., Пихтин Н.А., Фетисова Н.В., Лешко А.Ю., Слипченко С.О., Соколова З.Н., Рябоштан Ю.А., Мармалюк А.А., Тарасов И.С.

Мощные диодные лазеры ($\lambda = 1.7-1.8$ мкм) на основе асимметричных квантово-размерных гетероструктур раздельного ограничения InGaAsP/InP 1646

● **Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур**

Калтаев Х.Ш-о., Сидельникова Н.С., Нижанковский С.В., Данько А.Я., Ром М.А., Матейченко П.В., Добротворская М.В., Будников А.Т.

Получение текстурированных пленок нитрида алюминия методом термохимической нитридации сапфира 1650

Середин П.В., Глотов А.В., Домашевская Э.П., Арсентьев И.Н., Винокуров Д.А., Станкевич А.Л., Тарасов И.С.

Структурные и оптические свойства низкотемпературных МОС-гидридных гетероструктур AlGaAs/GaAs(100) на основе твердых растворов вычитания 1654